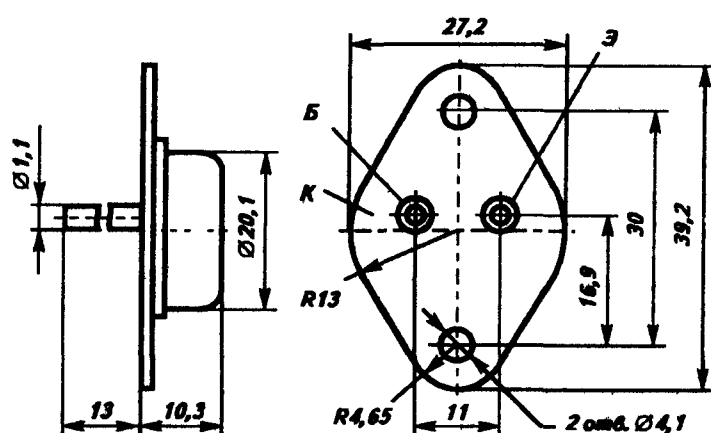


□ 2Т875А, 2Т875Б, 2Т875В, 2Т875Г

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *n-p-n* переключаемые. Предназначены для применения в усилителях и переключающих устройствах. Выпускаются в металлическом корпусе с жесткими выводами и стеклянными изоляторами. Масса транзистора не более 20 г.



2Т875(А-Г)

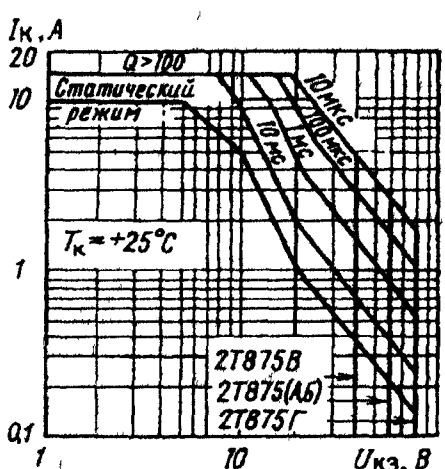
Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 5 В$, $I_э = 5 А$:	
2Т875А, 2Т875Б, 2Т875В	80...250
2Т875Г	40...160
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кэ} = 10 В$, $I_к = 0,5 А$	20...120 МГц
Граничное напряжение при $I_к = 30 мА$, не менее:	
2Т875А; 2Т875Б	60 В
2Т875В	40 В
2Т875Г	80 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_к = 5 А$, $I_б = 1 А$, не более	0,5 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_к = 5 А$, $I_б = 1 А$, не более	1,5 В
Время включения при $U_{кэ} = 30 В$, $I_к = 5 А$, $I_б = 0,5 А$; типовое значение ...	0,12* мкс
Время выключения при $U_{кэ} = 30 В$, $I_к = 5 А$, $I_б = 0,5 А$, типовое значение	0,4* мкс
Время спада при $U_{кэ} = 30 В$, $I_к = 5 А$, $I_б = 0,5 А$, типовое значение	0,05* мкс
Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 10 В$, типовое значение	910* пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{бэ} = 0,5 В$, типовое значение	5500* пФ
Обратный ток коллектора при $U_{кб} = U_{кб макс}$, не более	3 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{бэ} = 5 В$, не более	10 мА

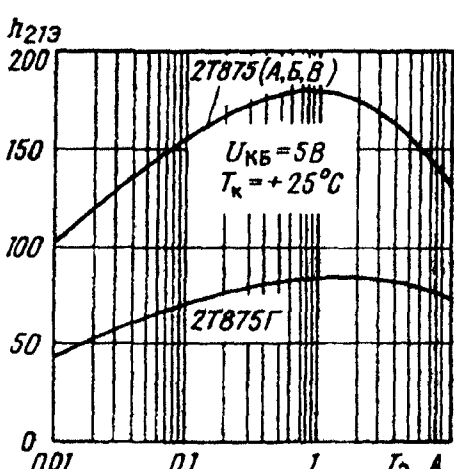
Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:	
2Т875А, 2Т875Г	90 В
2Т875Б	70 В
2Т875В	50 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер:	
при $R_{бэ} = 100 Ом$:	
2Т875А, 2Т875Г	90 В
2Т875Б	70 В
2Т875В	50 В
при $R_{бэ} = ∞$:	
2Т875А, 2Т875Б	60 В
2Т875В	40 В
2Т875Г	80 В
Постоянное напряжение база-эмиттер	5 В
Постоянный ток коллектора	10 А
Импульсный ток коллектора при $t_{и} = 10 мс$	15 А
Постоянный ток базы	3 А
Импульсный ток базы при $t_{и} = 10 мс$	5 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора ¹	
при $T_к = -60...+25^{\circ}C$:	
с теплоотводом	50 Вт
без теплоотвода	3 Вт
Температура <i>p-n</i> перехода	+150 ^o C
Температура окружающей среды	-60 ^o C... $T_к = +125^{\circ}C$

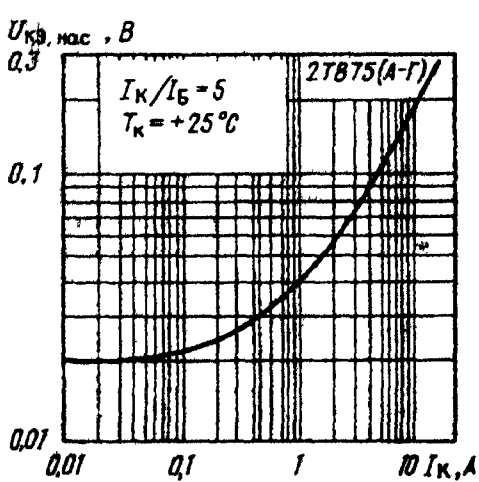
¹ При $T_к > +25^{\circ}C$ $P_к макс$ уменьшается линейно на 0,4 Вт/^oC с теплоотводом и на 20 мВт/^oC без теплоотвода.



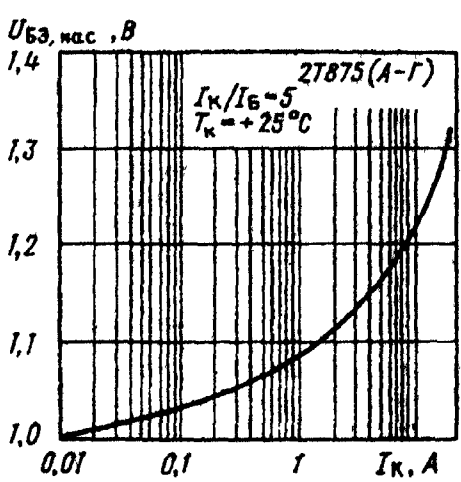
Области безопасной работы транзисторов



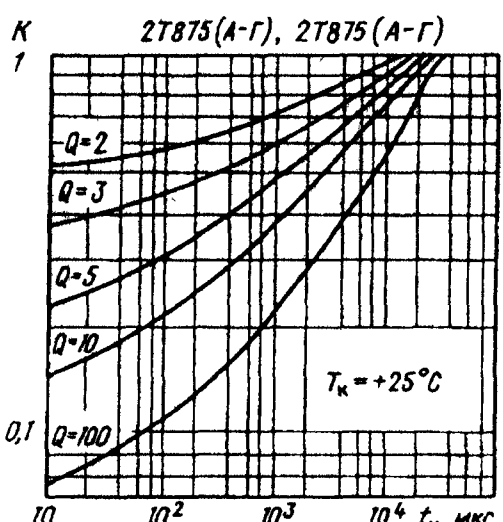
Зависимости статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора



Зависимости коэффициента К от длительности импульса